

DHA[®]

QJ/DHA 09.28-2018

LD630

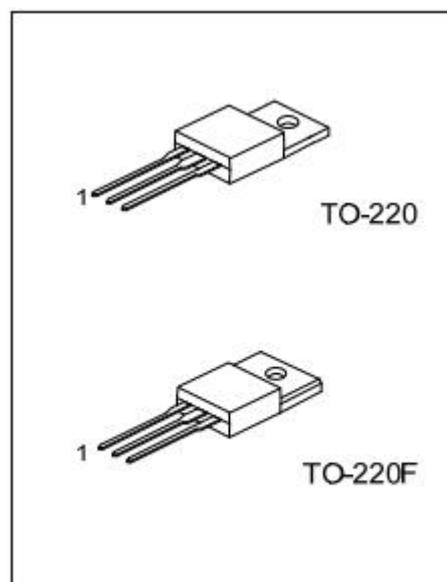
N-沟道 MOSFET 功率晶体管

描述

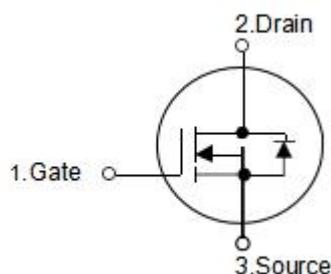
N 沟道 MOSFET 采用塑料 TO220 封装。符合 RoHS。

用途

适用于高速开关, 不间断电源, 电机控制, 音频放大器, 工业执行器。用于电信, 工业和消费者环境的 DC-DC 和 DC-AC 转换器。



等效电路图



电参数 (Tamb = 25°C)

缩写	参数	单位	最小值	典型值	最大值	测试条件
BV _{DSS}	漏极-源极 击穿电压	V	200	-	-	V _{GS} = 0 V, I _D = 250 μA
I _D	漏极连续电流	A	-	-	9.0	T _j = 25 °C
R _{DS(on)}	静态 漏极-源极 导通电阻	Ω	-	0.35	0.4	V _{GS} = 10 V, I _D = 4.5 A
V _{GS(th)}	栅极门限电压	V	2.0	-	4.0	V _{DS} = V _{GS} , I _D = 250 μA
I _{DSS}	漏极-源极 漏电流	μA	-	-	1	V _{DS} = 200 V, V _{GS} = 0 V
I _{GSS}	栅极-源极 漏电流	nA	-	-	100	V _{GS} = ± 25 V, V _{DS} = 0 V
T _j	工作结温	°C	- 55 ~ +150			
T _{STG}	储存温度范围	°C				

丹东华奥电子有限公司

<http://www.huaoe.com>